

Кроме пироксидов  $A_2V_2O_7$ , ферромагнетизм обнаружен в  $A_2Mo_2O_7$  [4],  $A_2Mn_2O_7$  [5] и  $A_2CrSbO_7$  [6]. В твердых растворах  $(La_{1-x}Y_x)_2Mo_2O_7$  по мере возрастания  $x$  наблюдался переход от ферромагнетизма к спиновому стеклу [7]. Сведений об антиферромагнитном упорядочении в пироксиде в литературе не имеется. Все пироксиды с тяжелыми редкоземельными ионами характеризуются положительной поляризацией или параллельным упорядочением магнитных моментов  $f$ - и  $d$ -ионов при переходе в магнитоупорядоченное состояние [3-7]. В парамагнитной области связь между  $f$ - и  $d$ -подсистемами может быть антиферромагнитной [4]. В молибдатах и манганатах обнаружена сильная зависимость магнитных свойств от природы А-катиона. Например, температура Кюри  $A_2Mn_2O_7$  ( $A = Se, Lu$ ) — 10 К, а  $In_2Mn_2O_7$  — 132 К [7].  $Gd_2Mo_2O_7$  — ферромагнетик с  $T_c$  — 85 К, а  $Y_2Mo_2O_7$  — спиновое стекло с  $T_f$  = 30 К [4]. В противоположность этим сериям в ванадатах  $T_c$  почти не зависит от состава. Температуры Кюри  $Lu_2V_2O_7$  и  $Yb_2V_2O_7$  равны 72.5 и 71 К соответственно [8].

Специфика магнитных свойств может быть обусловлена топологическими фрустрациями антиферромагнитных взаимодействий в структуре пироксида. Обмен между В-катионами в  $A_2B_2O_7$  осуществляется по цепочке В—О—В [8]. Каждый В-катион находится в кислородном октаэдре. Октаэдры соединяются вершинами, образуя трехмерный каркас. Однако в отличие от структуры перовскита ближайшие В-соседи любого В-катиона могут попарно взаимодействовать между собой через общий анион [8]. В этих условиях незначительный дополнительный обмен по цепочке В—О—А—О—В в манганатах или через носители тока в молибдатах может привести к резкому изменению свойств. По-видимому, в  $A_2V_2O_7$  существенны только обменные взаимодействия  $V^{4+}-O-V^{4+}$ , так как наблюдается очень слабая зависимость  $T_c$  от состава.

#### Список литературы

- [1] Базуев Г. В., Самохвалов А. А., Морозов Ю. Н. и др. // ФТТ. 1977. Т. 19. № 11. С. 3274—3278.
- [2] Souderholm L., Greedan J. E., Collins M. F. // J. Sol. St. Chem. 1980. V. 35. N 3. P. 385—390.
- [3] Базуев Г. В., Швейкин Г. П. Сложные оксиды элементов с дистраивающимися  $d$ - и  $f$ -оболочками. М.: Наука, 1985. С. 86.
- [4] Sato M., Xu Yan., Greedan J. E. // Z. Anorg. Chem. 1986. V. 540/541. P. 177—190.
- [5] Троянчук И. О., Деркаченко В. Н. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 11. С. 3487—3488.
- [6] Bongers P. F., von Meurs E. R. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. N 3. P. 944—945.
- [7] Sato M., Greedan J. E. // J. Sol. St. Chem. 1987. V. 67. N 2. P. 248—253.
- [8] Jona F., Shirane G., Pepinsky R. // Phys. Rev. 1955. V. 98. N 4. P. 903—909.

Институт физики твердого тела  
и полупроводников АН БССР  
Минск

Поступило в Редакцию  
5 января 1989 г.

## УЕДИНЕННЫЕ ВОЛНЫ В ОБЛАСТИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ВТОРОГО РОДА ДЛЯ КВАДРАТИЧНОЙ СВЯЗИ ПАРАМЕТРА ПОРЯДКА С НАПРЯЖЕНИЯМИ

В. И. Сериков, Т. А. Герасименко

Наличие автомодельных решений [1] в виде уединенных волн кинетического уравнения  $\dot{\eta} = L \delta \Phi / \delta \eta$  с потенциалом  $\Phi$  Ландау—Гинзбурга [2] при учете связи параметра порядка с напряжениями «индуцирует» уеди-

ненные волны напряжений или деформации. Для линеаризованных уравнений, т. е. кинетического уравнения и соответствующего уравнения теории упругости, существование связанных волн параметра порядка и деформаций или напряжений хорошо известно. В физике сегнетоэлектриков или ферромагнетиков существенный интерес представляют также решения, для которых значение параметра порядка противоположно по знаку для областей, расположенных по разные стороны от фронта волны. В статическом случае такое распределение описывает, например, поведение параметра порядка при переходе через доменную стенку [3]. Ниже рассматриваются уединенные волны такого вида, представляющие собой автомодельные решения системы уравнений

$$\eta_t = L\delta\Phi/\delta\eta, \quad \rho\epsilon_{tt} = \sigma_{xx} \quad (1)$$

с термодинамическим потенциалом

$$\Phi = \int \varphi(x) dx,$$

где

$$\varphi = f_0 + \frac{\alpha}{2} \eta^2 + \frac{\beta}{4} \eta^4 + \frac{\gamma}{2} (\eta_x)^2 - \frac{r}{2} \eta^2 \sigma - \frac{s}{2} \sigma^2. \quad (2)$$

$L$  — кинетический коэффициент,  $\rho$  — плотность,  $\epsilon = -\partial\varphi/\partial\sigma$  — деформация,  $\delta\Phi/\delta\sigma$  означает вариационную производную, а нижние индексы означают частное дифференцирование по соответствующей переменной. Вводя обозначения  $A=L\alpha$ ,  $B=L\beta$ ,  $D=L\gamma$ ,  $R=Lr$ , запишем систему (1) уравнений движения в форме

$$\eta_t = D\eta_{xx} - A\eta - B\eta^3 + R\eta\sigma, \quad \rho s\sigma_{tt} - \sigma_{xx} = -\rho^{r/2} (\eta^2)_{tt}. \quad (3)$$

Обозначая через  $\eta_0$  равновесное значение параметра порядка, отвечающее условию

$$\partial\Phi/\partial\eta|_{\eta=\eta_0} = 0,$$

а также  $v_s^2 = (\rho s)^{-1}$ ,  $g = \rho r$ , придадим системе уравнений (3) следующий вид:

$$\begin{aligned} \tilde{\eta}_t &= D\tilde{\eta}_{xx} + 2A\tilde{\eta} - B\tilde{\eta}^3 - 3B\eta_0\tilde{\eta}^2 + R\eta_0\sigma + R\eta_0\sigma, \\ \frac{1}{v_s^2} \sigma_{tt} - \sigma_{xx} &= -(g/2) (\tilde{\eta}^2)_{tt} - g\eta_0\tilde{\eta}_{tt}. \end{aligned} \quad (4)$$

Здесь  $\tilde{\eta} = \eta - \eta_0$  — отклонение параметра порядка от равновесного значения; кроме того, учтено, что для свободного кристалла напряжения в состоянии равновесия отсутствуют ( $\sigma_0 = 0$ ). Используя очевидное свойство волновых решений типа  $\sigma = \sigma(x - vt)$ ,  $\eta = \eta(x - vt)$ , запишем второе уравнение системы (4) в виде

$$(v_s^2 - v^2) \sigma_{tt} = -(g/2) (\tilde{\eta}^2)_{tt} - g\eta_0\tilde{\eta}_{tt}. \quad (5)$$

Тогда частное решение такого уравнения можно представить в форме

$$\sigma = (g/2 \cdot \eta^2 + g\eta_0\tilde{\eta} + c) v^2 / (1 - \mu^2), \quad (6)$$

где  $c$  — постоянная интегрирования, отличная от нуля;  $\mu = (v/v_s)$ . Подставляя (6) в первое уравнение системы (4) и рассматривая для  $\eta$  решение в виде уединенной волны

$$\eta = \eta_m \operatorname{th}((x - vt)/\Delta), \quad (7)$$

получим систему уравнений, определяющих параметры решения, в частности амплитуду  $\eta_m$ , скорость  $v$  и ширину  $\Delta$  уединенной волны

$$c = (1 - \mu^2)/6DR, \quad \eta_m = (-A/B)^{1/2}, \quad \Delta = -6D/v, \quad (8)$$

Квадрат скорости  $v$  определяется из уравнения

$$v^4/v_s^2 - v^2 [v_0^2(1/v_s^2 + 1/v_0^2) + 1] + v_0^2. \quad (9)$$

Здесь  $v_0 = \sqrt{18D(-A)}$  — скорость уединенной волны, которая является решением первого из уравнений системы (4) при  $r=0$ , а величина  $v_u^2 = Rg/2B$  — характерная поправка к  $r=0$ , возникающая во втором из уравнений системы (4) при его линеаризации (т. е. при  $\eta \ll \eta_0$  и соответственно  $\sigma = (-2A) \eta / (\eta_0 r)$ ). Дискриминант уравнения (9), как легко убедиться, является существенно положительным, поэтому одно из решений (9) определяет величину  $v$ .

Уединенную волну напряжений можно представить в форме

$$\sigma = \left[ -\frac{g\eta_0^2}{2} \operatorname{sech}^2 \xi + g\eta_0 \operatorname{th} \xi + \left( c + \frac{g\eta_0}{2} \right) \right] \frac{v^2}{1 - \mu^2}, \quad (10)$$

где  $\xi = (x - vt)/\Delta$ . Отметим, что для квадрата скорости имеет смысл лишь одно из решений уравнения (9), для которого  $v \rightarrow 0$  при  $v_0 \rightarrow 0$  (т. е. при  $A \rightarrow 0$ ). Второе решение, для которого  $v \rightarrow v_s$  при  $v_0 \rightarrow 0$ , не имеет смысла, так как напряжения (6) становятся при этом неопределенными.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Мелькер А. И., Овидько И. А. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 2. С. 594—597.  
 [2] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Статистическая физика. Ч. I. М.: Наука, 1976. С. 583.  
 [3] Струков Б. А., Леванюк А. П. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. М.: Наука, 1983. С. 239.

Липецкий политехнический институт  
Липецк

Поступило в Редакцию  
19 января 1989 г.

УДК 538.971

Физика твердого тела, том 31, в. 7, 1989  
Solid State Physics, vol. 31, № 7, 1989

## МАГНИТОПОВЕРХНОСТНЫЕ СОСТОЯНИЯ В СВЕРХРЕШЕТКАХ

Г. В. Мильников, И. М. Соколов

Рассмотрим полупроводниковую сверхрешетку [1], помещенную в сильное магнитное поле  $H$ , направленное вдоль слоев сверхрешетки. Ось  $z$  системы координат направлена вдоль поля, направления остальных осей показаны на рисунке, а. Граница сверхрешетки совпадает с плоскостью  $x=0$ . Исследуем влияние этой границы на электронные свойства системы. Поскольку  $k_x$  является хорошим квантовым числом, движения в плоскости  $xu$  и вдоль  $z$  разделяются. В дальнейшем будем рассматривать только двумерное движение. Гамильтониан имеет вид

$$\hat{H} = \left( \mathbf{p} - \frac{e}{c} \mathbf{A} \right)^2 / 2m + V(y) \equiv \hat{H}_0 + V, \quad (1)$$

где  $\mathbf{A} = Hx\mathbf{e}_y$ ;  $V(y)$  — периодическая с периодом  $T$  функция; эффективная масса  $m$  предполагается постоянной во всем образце. Спектр такой системы при отсутствии границы рассмотрен в работах [2, 3]. Интересующие нас состояния проще всего рассмотреть, когда магнитное поле оказывает существенное влияние на «атомные» состояния электрона в сверхрешетке [2]. Это соответствует пределу сильного поля  $\hbar\omega \gg V$ ,  $\omega = eH/mc$ . В этом приближении можно пренебречь смешиванием уровней Ландау и задача о нахождении спектра системы сводится к задаче об одномерной